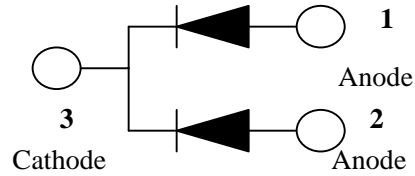




## Schottky Diode



## 肖特基二极管(FHBAT54C)

MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	$V_R$	30	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	$I_F$	200	mAdc

## THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	$P_D$	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底	$P_D$	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	$T_J, T_{stg}$	150, -55 to +150	

## DEVICE MARKING 打标

**FHBAT54C=3S**

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

( $T_A=25$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25 )

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
-------------------	-----------	---------	---------	---------

## OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流( $V_R=25Vdc$ )	$I_R$	—	1.0	$\mu A_{dc}$
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压( $I_{BR}=10 \mu A_{dc}$ )	$V_{(BR)}$	30	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 ( $I_F=0.1mAdc$ )	$V_F$	—	240	mVdc
( $I_F=1mAdc$ )		—	320	
( $I_F=10mAdc$ )		—	400	
( $I_F=30mAdc$ )		—	500	
( $I_F=100mAdc$ )		—	1000	
Total Capacitance 电容( $V_R=1V, f=1.0MHz$ )	$C_T$	—	10	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间( $I_F=I_R=10mAdc, R_L=100 \Omega$ )	$t_{rr}$	—	5.0	ns

- FR-5=1.0 × 0.75 × 0.062 in.
- Alumina=0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% alumina.



## SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

